

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАДИАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ НА ИЗДЕЛИЯ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ

Воздействие отдельных ядерных частиц на изделия микроэлектроники

Совместное использование лазерной и импульсной гамма-установок
при оценке параметров чувствительности БИС к эффектам воздействия
отдельных ядерных частиц

*А. И. Чумаков, А. Л. Васильев, А. А. Печенкин, Д. В. Савченков,
А. С. Тарараксин, А. В. Яненко*

243

Оценка чувствительности ПЛИС к эффектам воздействия
отдельных ядерных частиц

Д. В. Бобровский, О. А. Калашников, П. В. Некрасов

248

Моделирование локального воздействия ядерных частиц на 65 нм
КМОП ячейки памяти DICE

В. Я. Стенин, П. В. Степанов

253

Моделирование эффектов локальных воздействий ядерных частиц
на 65 нм КМОП элементы двухфазной логики

Ю. В. Катунин, В. Я. Стенин

262

Влияние радиационных факторов на стойкость изделий микроэлектроники

Анализ радиационного поведения импульсных стабилизаторов напряжения

Л. Н. Кессаринский, Д. В. Бойченко, А. Ю. Никифоров

275

Дозовая деградация динамических параметров микросхем памяти

А. Б. Боруздина, А. В. Уланова, Н. Г. Григорьев, А. Ю. Никифоров

284

Исследование возможности разработки радиационно-стойких БИС
навигационного назначения по отечественной КМОП КНИ
технологии с нормами 0.35 мкм

В. В. Елесин, Г. Н. Назарова, Г. В. Чуков, Ю. А. Кабальнов, А. А. Титаренко

291

Моделирование радиационных эффектов в изделиях микроэлектроники

Особенности переноса электронов в биполярных транзисторных
структурах с тонкой базой при воздействии потока квантов высоких энергий

А. С. Пузанов, С. В. Оболенский

304